

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成24年12月20日 (2012.12.20)

【公表番号】特表2012-507606(P2012-507606A)

【公表日】平成24年3月29日 (2012.3.29)

【年通号数】公開・登録公報2012-013

【出願番号】特願2011-534764(P2011-534764)

【国際特許分類】

C 0 8 J 7/00 (2006.01)

C 0 8 J 3/24 (2006.01)

C 0 9 J 183/04 (2006.01)

C 0 9 J 11/04 (2006.01)

C 0 9 J 11/06 (2006.01)

C 0 9 J 7/02 (2006.01)

C 0 8 L 83/04 (2006.01)

B 3 2 B 27/00 (2006.01)

C 0 9 J 183/02 (2006.01)

【F I】

C 0 8 J 7/00 3 0 2

C 0 8 J 3/24 C F H

C 0 9 J 183/04

C 0 9 J 11/04

C 0 9 J 11/06

C 0 9 J 7/02 Z

C 0 8 L 83/04

B 3 2 B 27/00 1 0 1

C 0 9 J 183/02

【手続補正書】

【提出日】平成24年10月29日 (2012.10.29)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

シリコン材料を含む組成物をホットメルト処理する工程と、前記組成物を電子ビーム照射にさらして架橋シリコン系材料を形成する工程とを含み、前記組成物には、実質的に触媒及び開始剤がない、架橋シリコン系材料を作製する方法。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の方法によって作製された、架橋シリコン系材料。

【請求項 3】

第 1 の主面を有する基材と、前記基材の前記第 1 の主面の少なくとも一部分に接着されたシリコン感圧性接着剤とを含む、接着性物品。